

# FM 深圳市富满电子集团股份有限公司

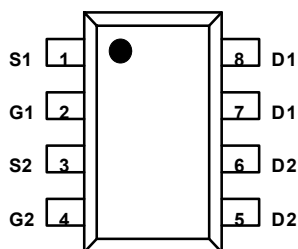
## SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

**9926A**(文件编号: S&CIC1368)

**20V N 沟道增强型 MOS 场效应管**

$R_{DS(ON)}, V_{GS}@2.5V, I_{DS}@5.0A = 42m\Omega$

$R_{DS(ON)}, V_{GS}@4.5V, I_{DS}@6.0A = 30m\Omega$



SOP-8

**绝对最大额定值** ( $T_A=25^\circ C$ , 除非另有注明)

参数	符号	最大值	单位
漏源极电压	$V_{DS}$	20	V
栅源极电压	$V_{GS}$	$\pm 10$	V
连续漏电流	$I_D$	$T_A=25^\circ C$	6
		$T_A=70^\circ C$	4.2
脉冲漏电流	$I_{DM}$	20	A
功耗	$P_D$	$T_A=25^\circ C$	2
		$T_A=70^\circ C$	1.28
温度范围	$T_J, T_{STG}$	-55~150	$^\circ C$

**热特性**

参数	符号	典型值	最大值	单位
最大管结温度	$R_{\theta JA}$	56	62.5	$^\circ C/W$
最大管结温度				
最大热阻	$R_{\theta JL}$	40	48	$^\circ C/W$



# 深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

9926A(文件编号: S&CIC1368)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

## 电特性

( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , 除非另有注明)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>静态部分</b>						
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	20			V
Drain-source 导通内阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 4.5V, I_{DS} = 6A$		21	30	$m\Omega$
Drain-source 导通内阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 2.5V, I_{DS} = 5A$		26	42	$m\Omega$
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	0.5	0.75	1	V
漏源极漏电流	$I_{DSS}$	$V_{DSS} = 20V, V_{GS} = 0V$			1	$\mu A$
栅源极漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 12V, V_{DS} = 0V$			$\pm 100$	nA
<b>动态部分</b>						
栅极总电荷	$Q_G$	$V_{DS} = 10V, I_D = 6A$ $V_{GS} = 4.5V$		6.24	8.11	nC
栅源电荷	$Q_{GS}$			1.64	2.13	
栅漏电荷	$Q_{GB}$			1.34	1.74	
开始延迟时间	$T_{d(on)}$	$V_{DD} = 10V, I_D = 6A$ $I_D = 1A, V_{GS} = 4.5V$		10.4	20.8	ns
上升时间	$T_r$			4.4	8.8	
关闭延迟时间	$T_{d(off)}$			27.36	54.72	
下降时间	$T_f$			4.16	8.32	
输入电容	$C_{iss}$	$V_{DS} = 8V, V_{GS} = 0V$ $f = 1.0MHz$		522.3		pF
输出电容	$C_{oss}$			98.48		
反向传输电容	$C_{rss}$			74.69		
<b>源漏极二极管</b>						
二极管最大正向电流	$I_S$				1.7	A
二极管正向电压	$V_{SD}$	$I_S = 1.7A, V_{GS} = 0V$		0.74		V



# 深圳市富满电子集团股份有限公司

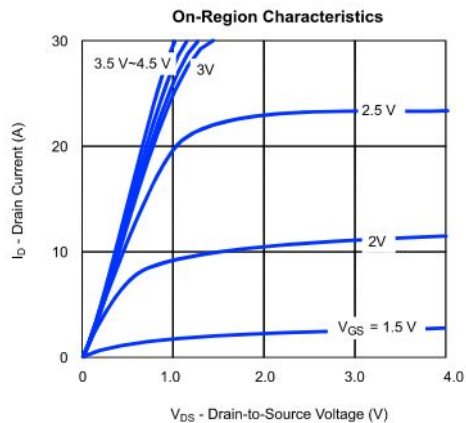
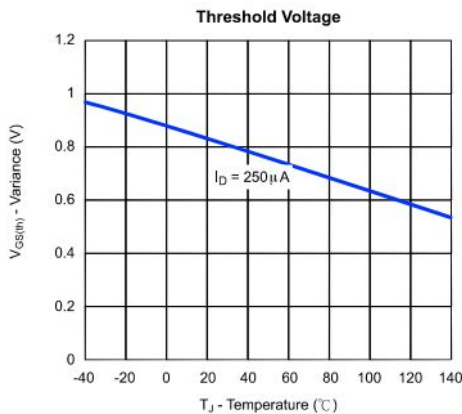
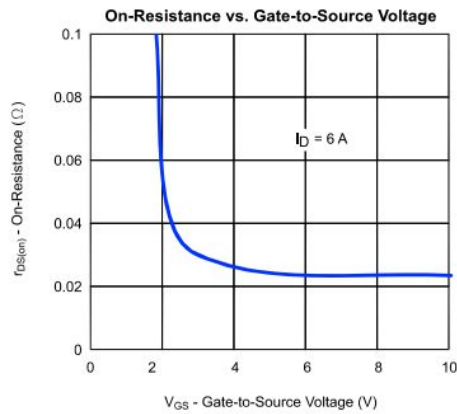
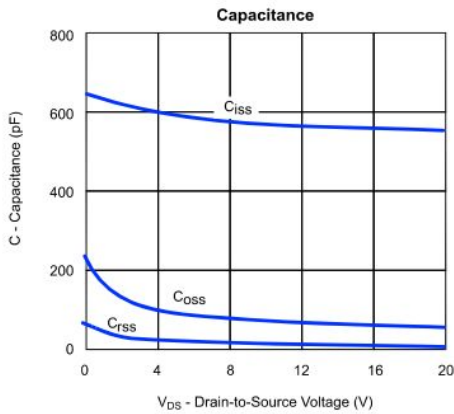
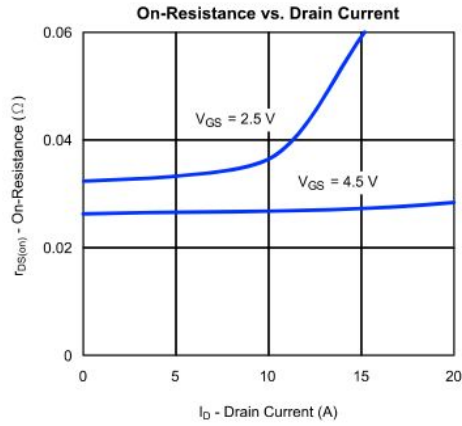
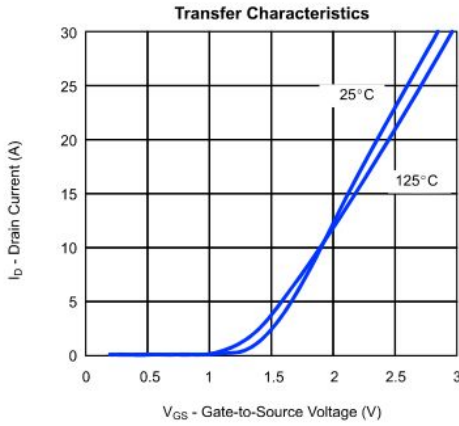
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

9926A(文件编号: S&CIC1368)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

## 曲线图

Typical Characteristics (T<sub>J</sub> = 25°C Noted)





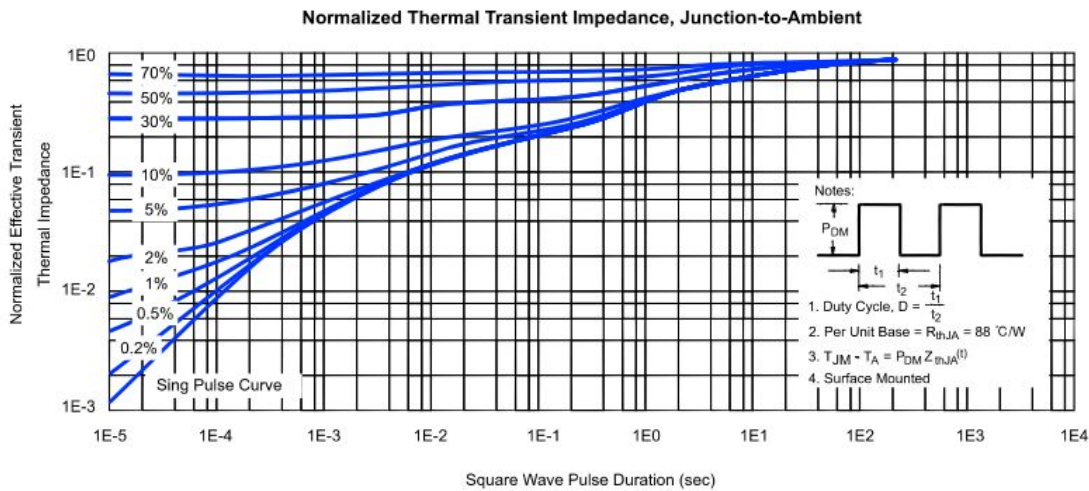
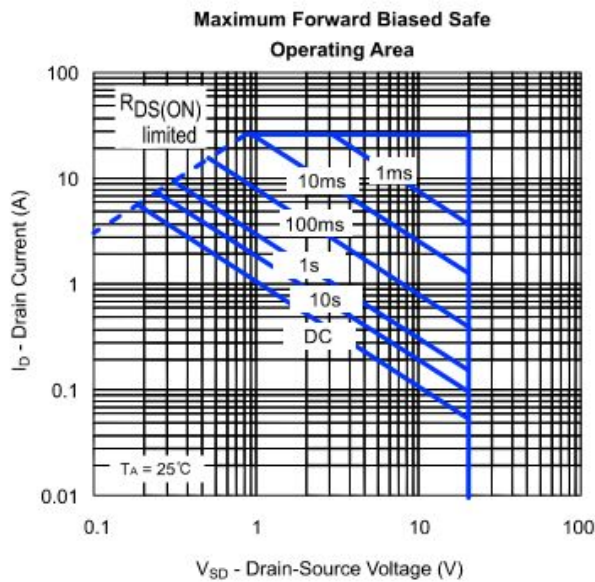
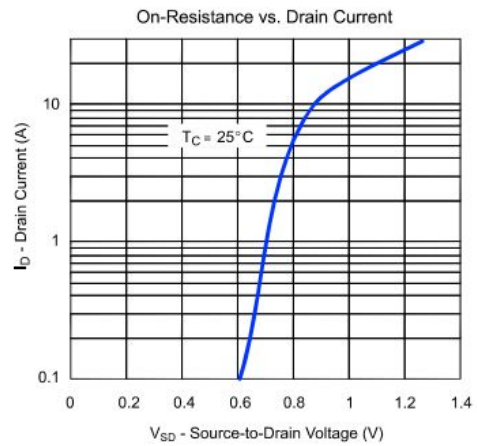
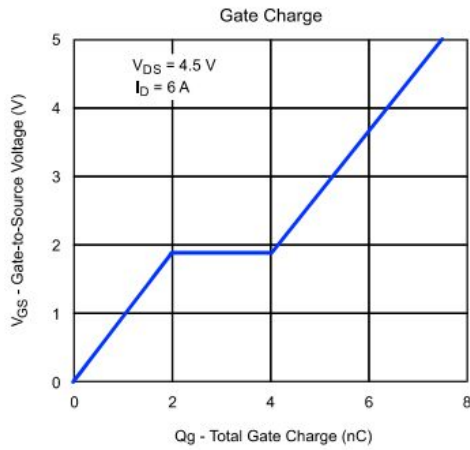
# 深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

9926A(文件编号: S&CIC1368)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

## Typical Characteristics (T<sub>J</sub> = 25°C Noted)





深圳市富满电子集团股份有限公司

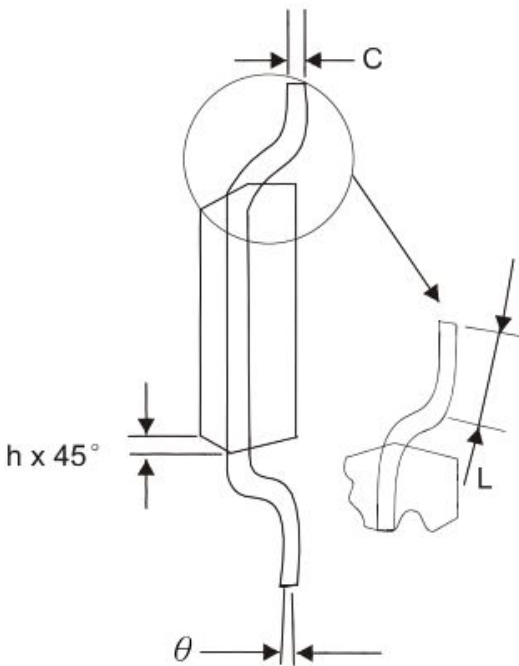
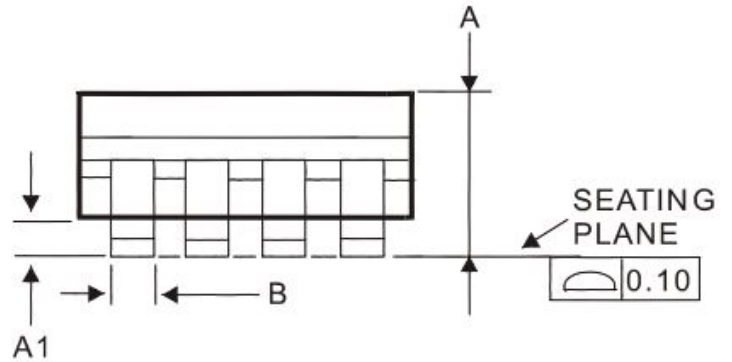
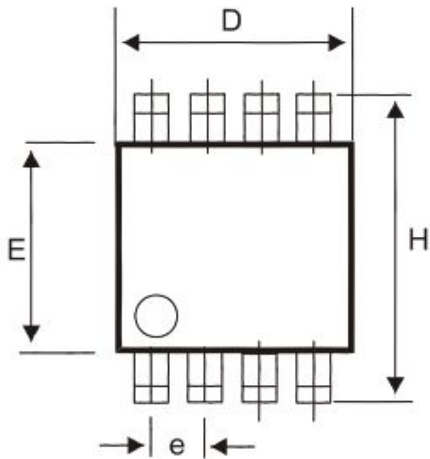
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

9926A(文件编号: S&CIC1368)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

包装尺寸

### SOP-8 Package Outline



DIM	MILLIMETERS	
	MIN	MAX
A	1.35	1.75
A1	0.10	0.25
B	0.35	0.49
C	0.18	0.25
D	4.80	5.00
E	3.80	4.00
e	1.27 BSC	
H	5.80	6.20
h	0.25	0.50
L	0.40	1.25
θ	0°	7°